

Rys. 1-676. GC123

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy *p-n-p* w obudowie metalowej, ciężar około 0,8 G

Zastosowanie: układy m.cz. z dużą wytrzymałością napięciową

Typy podobne: OC77 (Ph, Tes), OC1077 (Tung), ASY81 (Ses), TG51 (Cemi)

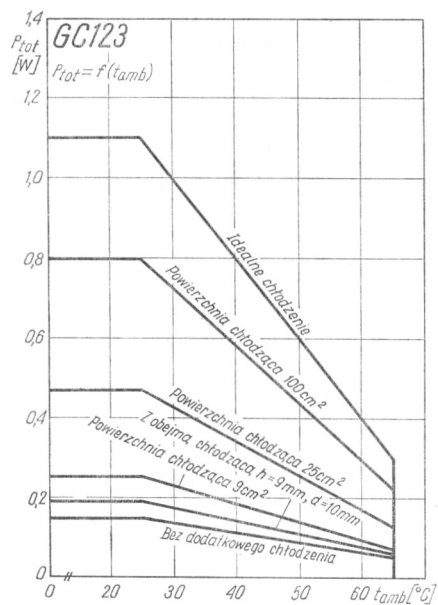
Wartości charakterystyczne

	min	typ	max		
$-I_{CB0}$		9	18	μA	przy $-U_{CB} = 15\text{ V}$
$-I_{CER}$			100	μA	przy $-U_{CER} = 66\text{ V}$, $R_{BE} = 1\text{ k}\Omega$
$-I_{EBO}$		12	50	μA	przy $-U_{EB} = 10\text{ V}$
f_{h21e}	12			MHz	przy $-U_{CE} = 2\text{ V}$, $-I_C = 10\text{ mA}$
h_{21E} (A)	18		35	}	przy $-U_{CE} = 0,5\text{ V}$, $-I_C = 100\text{ mA}$
(B)	28		56		
(C)	45		90		
(D)	71		140		
$h_{21E}(I_C = 100\text{ mA})$	1,3				
$h_{21E}(I_C = 250\text{ mA})$					

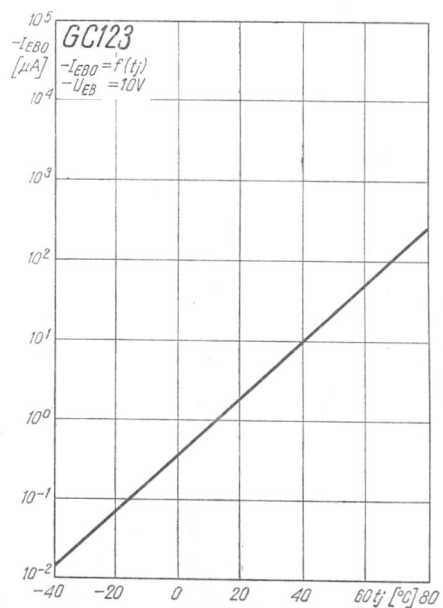
Wartości graniczne

$-U_{CBC\text{ max}}$	70	V	$t_{j\text{ max}}$	+80	$^{\circ}\text{C}$
$-U_{CER\text{ max}}$	66 ¹⁾	V	t_{amb}	-25 ÷ +65	$^{\circ}\text{C}$
$-U_{EBO\text{ max}}$	15	V	$R_{th\text{ j-a max}}$	0,38	$^{\circ}\text{C/mW}$
$-I_{C\text{ max}}$	250	mA	$R_{th\text{ j-c max}}$	0,05	$^{\circ}\text{C/mW}$
$-I_{B\text{ max}}$	50	mA			

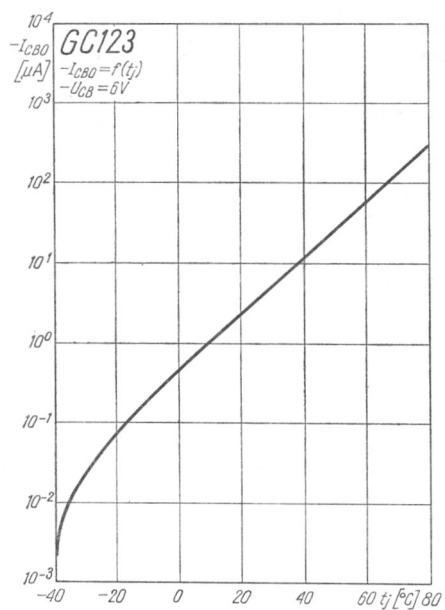
¹⁾ $R_{BE} = 1\text{ k}\Omega$



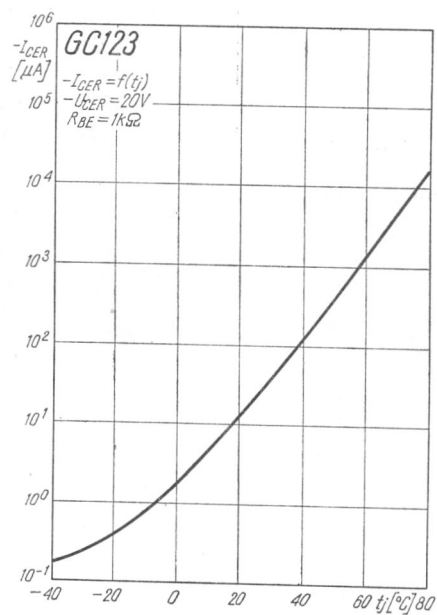
Rys. 1-677. Zależność mocy strat od temperatury otoczenia



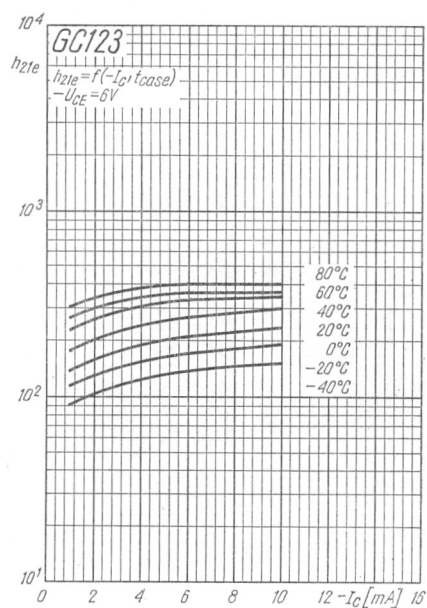
Rys. 1-678. Zależność prądu zerowego emitera od temperatury złącza



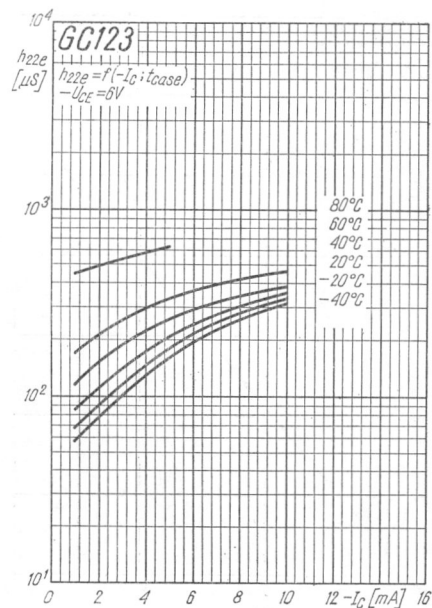
Rys. 1-679. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



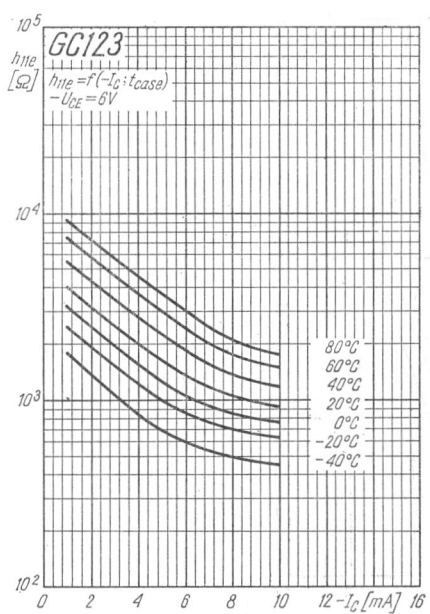
Rys. 1-680. Zależność prądu kolektora I_{CER} od temperatury złącza



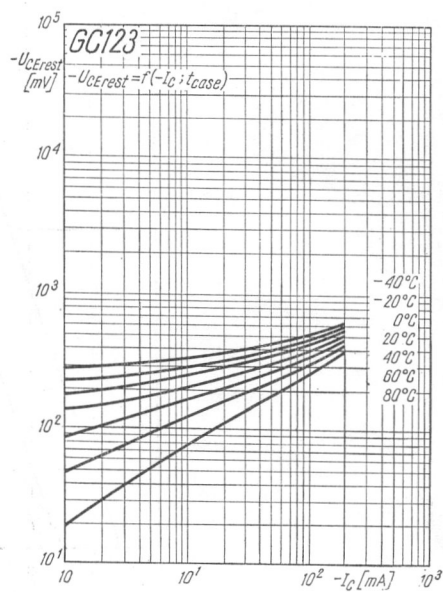
Rys. 1-681. Zależność dynamicznego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



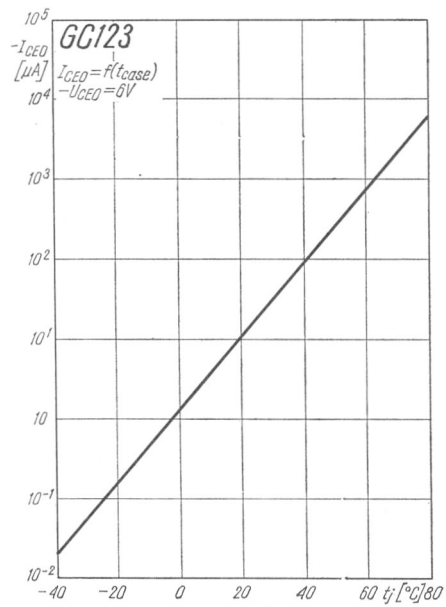
Rys. 1-682. Zależność admitancji wyjściowej od prądu kolektora



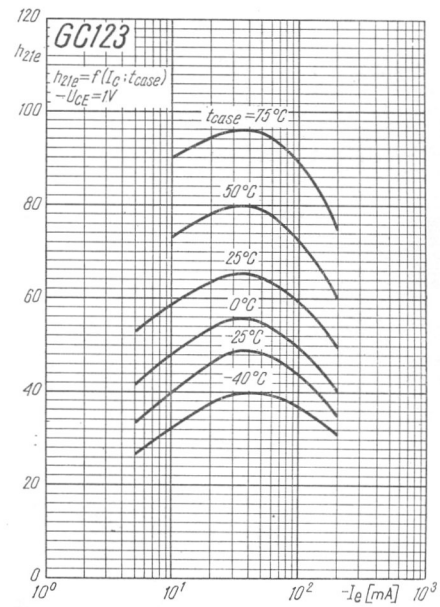
Rys. 1-683. Zależność impedancji wejściowej od prądu kolektora



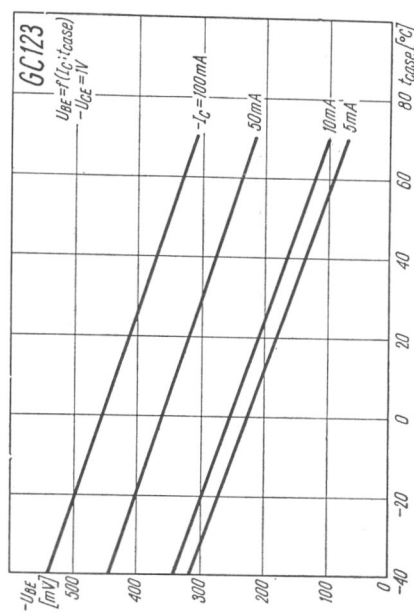
Rys. 1-684. Zależność napięcia szczytkowego kolektora od prądu kolektora



Rys. 1-685. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury złącza



Rys. 1-686. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



Rys. 1-687. Zależność napięcia baza-emiter od temperatury obudowy